

カスタムPtfе半導体ウェハ洗浄バスケット

耐腐食性・低バックグラウンド・ラボラック

商品番号: PL-CP267



前書き

弊社のカスタムPTFE洗浄バスケットで、半導体製造における最高純度を実現します。極めて高い耐薬品性と低バックグラウンド干渉を実現するよう設計されたこれらの耐久性のあるラックは、重要な高純度ラボ環境において、効率的なウェハ処理、迅速な排水、および信頼性の高いパフォーマンスを保証します。

詳細を学ぶ

アプリケーション	説明	主なメリット
RCA洗浄プロセス	シリコンウェハから有機残留物と金属汚染を除去するために、SC-1およびSC-2シーケンス中に使用されます。	超純度で低溶出性の材料表面により、再汚染を防止します。
ピラニアエッチング	レジスト除去のために、硫酸と過酸化水素の混合液中でウェハを処理します。	構造的劣化なしに、攻撃的な酸化環境に対する例外的な耐性を発揮します。
フッ化水素酸ディッピング	濃縮または緩衝HF溶液を使用して、シリコン基板から自然酸化膜を除去します。	HF攻撃に対する完全な耐性により、機器の長寿命とプロセスの純度が保証されます。
CMP後リンス	化学機械研磨（CMP）後にウェハを洗浄し、スラリー粒子と化学薬品を除去します。	迅速な排水と非粘着特性により、スラリー粒子がバスケットに付着するのを防ぎます。
フォトリソグラフィ現像	フォトレジスト層の現像および剥離中に基板をサポートします。	高い寸法安定性により、重要なリソグラフィ工程中の正確なアライメントとハンドリングが保証されます。
トレース分析準備	ICP-MSおよびその他の高感度分析技術で使用される実験器具と容器を洗浄します。	極めて低いバックグラウンドレベルにより、金属不純物のトレース検出における最高の精度が保証されます。
GaAsウェハ処理	特殊なエッチングおよびリンスサイクルを通じて化合物半導体ウェハを処理します。	優しいサポート構造により、脆い化合物半導体材料の破損を防ぎます。
超音波洗浄	高周波音響洗浄サイクル中に、浸漬キャリアとして機能します。	超音波エネルギーを効率的に伝達しながら、ウェハがタンクと機械的に接触するのから保護します。

機能	PL-CP267の仕様詳細
モデル識別子	PL-CP267
主な材料	高純度バージンPTFE（ポリテトラフルオロエチレン）
製造プロセス	100%精密CNC加工（射出成形残留物なし）
耐薬品性	HF、H2SO4、HNO3、HCl、KOH、および有機溶媒に対する完全な耐性
温度範囲	-200°C～+260°C（-328°F～+500°F）
表面仕上げ	微粒子の捕捉を最小限に抑えるための滑らかで低気孔率の仕上げ

機能	PL-CP267の仕様詳細
構成オプション	完全カスタマイズ可能（ウェハサイズ、スロット幅、スロットピッチ、ハンドル設計）
ウェハ互換性	2インチ、3インチ、4インチ、6インチ、8インチ、および12インチウェハまたはカスタム寸法に適用
排水設計	最適化された流体流出のために、V字型またはU字型スロットプロファイルが利用可能
バックグラウンドレベル	サブppb金属不純物要件向けに特別に処理